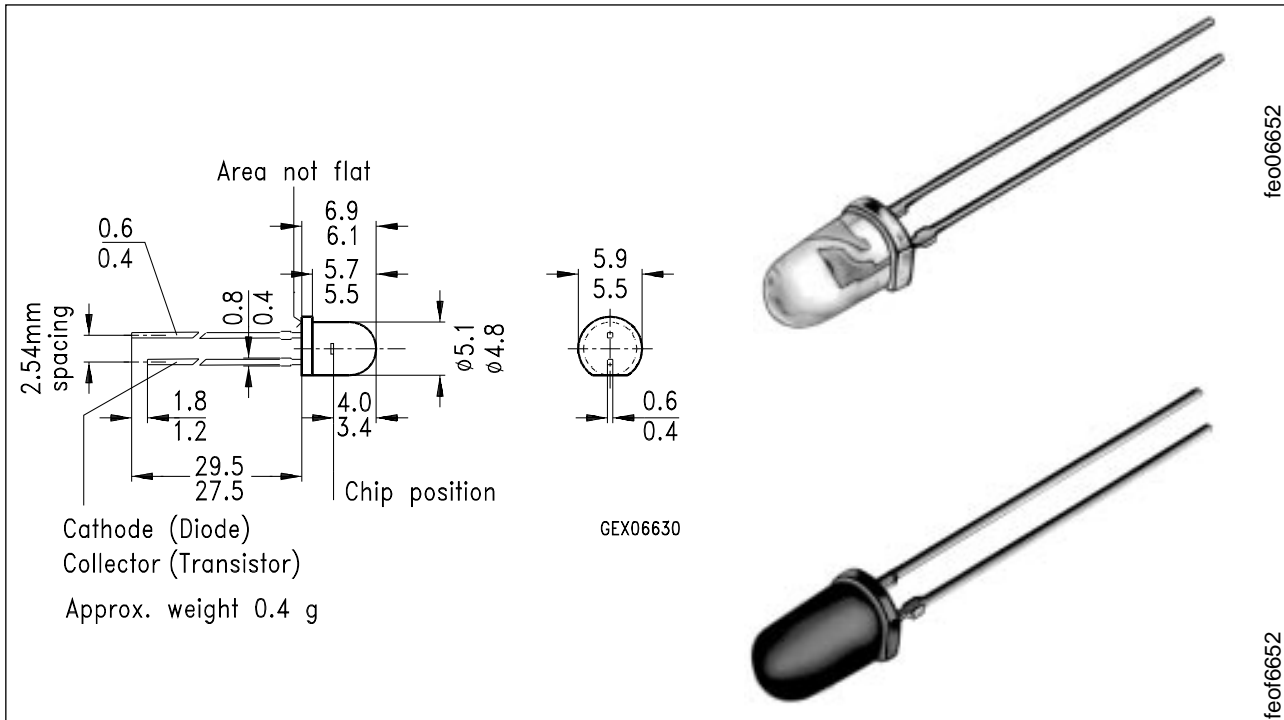


**Neu: Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit**  
**New: Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time**

**SFH 214**  
**SFH 214 FA**



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

## Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm (SFH 214) und bei 880 nm (SFH 214 FA)
- Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns)
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Auch gegurtet lieferbar

## Anwendungen

- Industrieelektronik
- "Messen/Steuern/Regeln"
- Schnelle Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- LWL

## Features

- Especially suitable for applications from 400 nm to 1100 nm (SFH 214) and of 880 nm (SFH 214 FA)
- Short switching time (typ. 5 ns)
- 5 mm LED plastic package
- Also available on tape

## Applications

- Industrial electronics
- For control and drive circuits
- Photointerrupters
- Fiber optic transmission systems

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
SFH 214	Q62702-P922
SFH 214 FA	Q62702-P1672

## Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 55 ... + 100	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3$ s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ( $t \leq 3$ s)	$T_S$	300	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	50	V
Verlustleistung Total power dissipation	$P_{tot}$	100	mW

## Kennwerte ( $T_A = 25$ °C) Characteristics

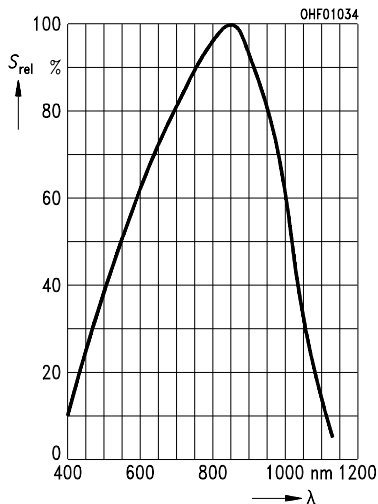
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		SFH 214	SFH 214 FA	
Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_R = 5$ V, Normlicht/standard light A, $T = 2856$ K, $V_R = 5$ V, $\lambda = 870$ nm, $E_e = 1$ mW/cm <sup>2</sup>	$S$	45 ( $\geq 30$ )	-	nA/lx
	$S$	-	25 ( $\geq 20$ )	$\mu$ A
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\ max}$	850	900	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10$ % von $S_{max}$ Spectral range of sensitivity $S = 10$ % of $S_{max}$	$\lambda$	400 ... 1100	750 ... 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	$A$	1	1	mm <sup>2</sup>
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	1 × 1	1 × 1	mm × mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	$H$	3.4 ... 4.0	3.4 ... 4.0	mm

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )  
**Characteristics** (cont'd)

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		SFH 214	SFH 214 FA	
Halbwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 40$	$\pm 40$	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_R = 20\text{ V}$ Dark current	$I_R$	1 ( $\leq 5$ )	1 ( $\leq 5$ )	nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit, $\lambda = 850\text{ nm}$ Spectral sensitivity	$S_\lambda$	0.62	0.59	A/W
Quantenausbeute, $\lambda = 850\text{ nm}$ Quantum yield	$\eta$	0.89	0.86	<u>Electrons</u> Photon
Leerlaufspannung Open-circuit voltage $E_v = 1000\text{ lx}$ , Normlicht/standard light A, $T = 2856\text{ K}$ $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $\lambda = 870\text{ nm}$	$V_O$  $V_O$	380 ( $\geq 300$ ) –	– 340 ( $\geq 290$ )	mV mV
Kurzschlußstrom Short-circuit current $E_v = 1000\text{ lx}$ , Normlicht/standard light A, $T = 2856\text{ K}$ $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $\lambda = 870\text{ nm}$	$I_{SC}$  $I_{SC}$	42 –	– 12	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 50\ \Omega$ ; $V_R = 20\text{ V}$ ; $\lambda = 850\text{ nm}$ ; $I_p = 800\ \mu\text{A}$	$t_r, t_f$	5	5	ns
Durchlaßspannung, $I_F = 80\text{ mA}$ , $E = 0$ Forward voltage	$V_F$	1.3	1.3	V
Kapazität, $V_R = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ Capacitance	$C_0$	11	11	pF
Temperaturkoeffizient von $V_O$ Temperature coefficient of $V_O$	$TC_V$	– 2.6	– 2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von $I_{SC}$ Temperature coefficient of $I_{SC}$ Normlicht/standard light A $\lambda = 870\text{ nm}$	$TC_I$	0.18 –	– 0.2	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_R = 10\text{ V}$ , $\lambda = 850\text{ nm}$	$NEP$	$2.9 \times 10^{-14}$	$2.9 \times 10^{-14}$	$\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
Nachweisgrenze, $V_R = 20\text{ V}$ , $\lambda = 850\text{ nm}$ Detection limit	$D^*$	$3.5 \times 10^{12}$	$3.5 \times 10^{12}$	$\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$

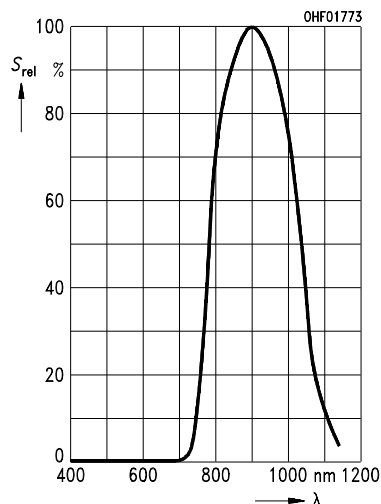
### Relative spectral sensitivity SFH 214

$$S_{rel} = f(\lambda)$$



### Relative spectral sensitivity SFH 214 FA

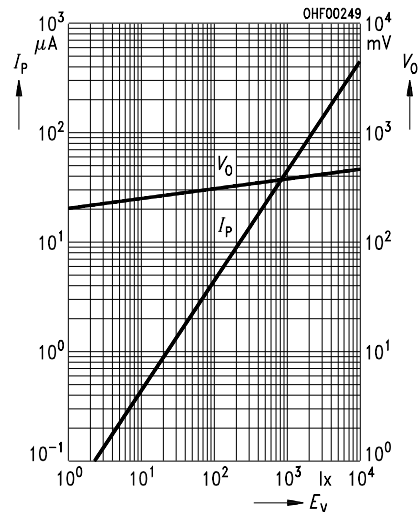
$$S_{rel} = f(\lambda)$$



### Photocurrent $I_P = f(E_v)$ , $V_R = 5 V$

### Open-circuit voltage $V_O = f(E_v)$

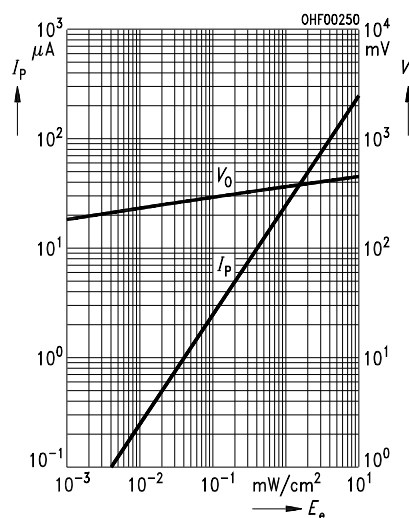
### SFH 214



### Photocurrent $I_P = f(E_e)$ , $V_R = 5 V$

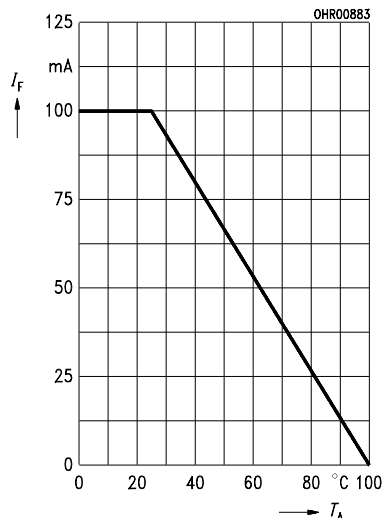
### Open-circuit voltage $V_O = f(E_e)$

### SFH 214 FA



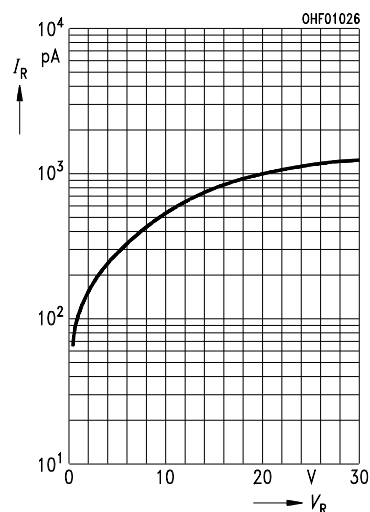
### Total power dissipation

$$P_{tot} = f(T_A)$$



### Dark current

$$I_R = f(V_R), E = 0$$



### Directional characteristics $S_{rel} = f(\varphi)$

